

850nm 10Gbps GaAs PD Chip $\phi 60\mu m$



产品描述

850nm GaAs PIN 高速光探测器芯片

产品特点

数据速率高达 10–40Gbps； $\phi 60\mu m$ 有效面积；850nm 高响应度；正面阳极/阴极焊盘

应用领域

10G/40G SR4 AOC | 4×10Gbps 光纤通道 | 40Gbps QSFP | HDMI 2.1

核心参数

无
无



021-56461550



021-64149583

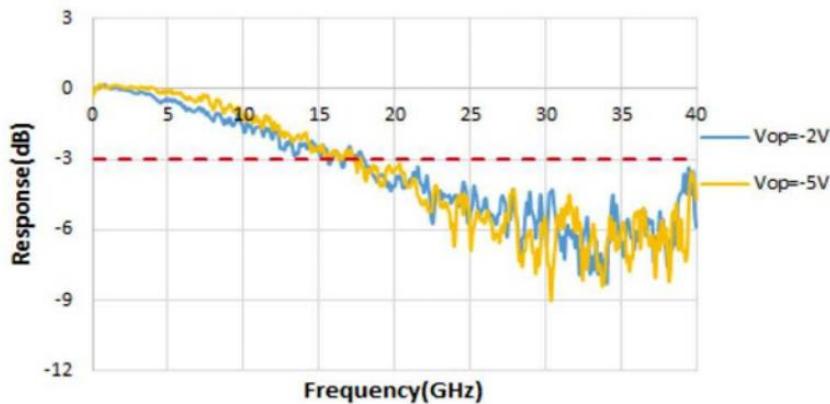


info@microphotons.com



www.microphotons.com

详细参数



规格 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$, 单颗裸芯片)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ		850	860	nm	
响应度	R	0.55	0.6		A/W	$\lambda=850\text{nm}$
暗电流	I_d		0.08	0.3	nA	$V_R=-5\text{V}$
电容	C		0.14	0.16	pF	$V_R=-2\text{V}, f=1\text{MHz}$
带宽	Bw		12		GHz	$V_R=-2\text{V}$ $3\text{dB down}, RL=50\Omega$
有效区直径	D		60		um	
通道之间的中心间距 (pitch)			250		um	

